# フレキシブル全固体薄膜二次電池の創製を目指した

## 革新負極技術の開発

筑波大学大学院数理物質科学研究科 博士前期課程2年(助成時)

#### 中島 義基

#### 【研究目的】

電気自動車や携帯機器のバッテリーの革新を目指し、二次電池の全固体化・薄膜化の研究 が活発化している。中でも、ガラスやプラスチックなどの安価な絶縁基板上に形成した「フ レキシブル全固体薄膜二次電池」は小型・軽量化が可能であり、高い設置自由度を有する究 極の電池形態と言える。しかし、現行の負極材料であるバルク・グラファイトは、3000℃の 高温で合成されるため、弱耐熱基板を用いる薄膜電池への応用は不可能である。報告者らは これまでに、独自技術である炭素と金属の「層交換」を利用し、600℃の低温における高品 質なグラファイト薄膜のガラス上直接合成に成功した【ACS Appl. Mater. Interfacs 10, 41664 (2018)】。本研究では、「層交換」をシーズとし、①グラファイト薄膜の高品質化と合成温度 の低温化、②グラファイト薄膜の導電膜上合成と負極特性評価を検討した。

### 【研究成果】

### ① グラファイト薄膜の高品質化と合成温度の低温化

層交換によるグラファイト薄膜のプラスチック (ポリイミド、耐熱温度:400 ℃)上直接合成には、 あと200 ℃の温度低減が必須である。そこで、層 交換温度の低温化に実績のある、過飽和促進層の 導入を検討した。

層交換の模式図を示す(図1(a))。SiO2ガラス基 板上に過飽和促進層(非晶質炭素)、Ni50nm、非晶 質炭素 50 nm をスパッタ堆積後、N2 雰囲気中で 400-800℃の熱処理を施し、層交換を誘起した。そ の際、過飽和促進層の膜厚(*t*und)を 0-20 nm と変調 した。

ラマンスペクトルより、 $t_{und} = 1 \text{ nm}$  試料において のみ、450 ℃以下でグラファイト薄膜の形成が確 認された。また、ラマンスペクトルの G/D 強度比 は、 $t_{und} = 1 \text{ nm}$  で最大となった(図 1(b))。これよ り、合成温度およびグラファイト薄膜の結晶性の



図 1. (a) 層交換の模式図 (b) ラマンスペクトル におけるG/D強度比 (c,d) 断面SEM像 (e) EDX像 (f,g) 高倍率断面TEM像

両観点から、 $t_{und} = 1 \text{ nm}$  が最適であると言える。 $t_{und} = 1 \text{ nm}$ 、 $400 \,^{\circ}$ C熱処理試料の断面観察より、層交換が発現し、高配向かつ均一なグラファイト薄膜の形成が確認された( $\bigcirc 1(c-g)$ )。

以上より、過飽和促進層の挿入により層交換温度を 200 ℃低減し、400 ℃の低温における 高品質なグラファイト薄膜の合成に成功した。

#### ② グラファイト薄膜の導電膜上合成と負極特性評価

Ni と非晶質炭素の初期位置を逆にした「逆層交換」を用いることで、グラファイト薄膜(活物質)/ Ni(集電体)という負極構造を、任意の基板上に自己組織的に形成することが可能である。そこで、 グラファイト薄膜の逆層交換合成、およびその負極特性評価を検討した。

逆層交換の模式図を示す(図 2(a))。Mo 箔上に非晶質炭素 100 nm、Ni 100 nm をスパッタ 堆積後、N2 雰囲気中で 600 ℃の熱処理を施し、逆層交換を誘起した。なお、負極特性評価に 現行のコインセルを用いるため、導電性のある Mo 箔を基板に使用した。電池構造は、対極 に金属 Li 箔を、電解液に 1 mol L<sup>-1</sup> LiPF<sub>6</sub> in EC/DEC(1:1 in volume)を用いたハーフセルであ る。負極特性評価として、CV 測定、充放電試験、およびレート特性評価をそれぞれ 0.01–2.0 V の範囲で行った。

熱処理後の試料の断面観察より、逆層交換が発 現し、均一なグラファイト薄膜の形成が確認され た(図 2(b))。CV 測定の結果、0.06、0.09 V に明瞭 なピークが得られた(図 2(c))。これらは、グラフ ェン層間への Li のインターカレーションに起因す るピークである。充放電試験の結果、100 サイクル 後の放電容量は、初期放電容量の 84%である、7.2 μAh cm<sup>-2</sup>(392 mAh g<sup>-1</sup>)を維持した(図 2(d))。また、 初期クーロン効率は不可逆容量を反映して 59%と 低い一方、100 サイクル後には 98.2%となった。レ ート特性評価の結果、68.0 μA cm<sup>-2</sup> での容量は、0.7 μA cm<sup>-2</sup> での容量の 41% (3.6 μAh cm<sup>-2</sup>)を維持した (図 2(e))。

以上より、逆層交換を用いて 600 ℃の低温で均 ーなグラファイト薄膜を合成すると共に、負極構 造の自己組織的形成に成功した。更に、その負極動 作を初実証すると共に、バルク・グラファイトに匹 敵する容量を達成した。

以上の成果は「フレキシブル全固体薄膜二次電 池」の可能性を拓く革新技術である。

